

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2009 г.

Современные электронные технологии		
Обеспечение заданной длины проводников в САПР ТороR. <i>Лысенко А. А., Полубасов О. Б.</i>	4	Метод расчета сопротивления электродов тонкопленочного резистора. <i>Спирин В. Г.</i>
Новые компоненты для электронной аппаратуры		Системы передачи и обработки сигналов
Органические светоизлучающие структуры — технологии XXI века. <i>Сорокин В. М., Коломзаров Ю. В., Маслак-Гудима Н. П., Миняйло М. А.</i>	1	Алгоритмическая фильтрация помех методом α -усеченного среднего в устройствах преобразования «угол–код». <i>Гордиенко В. И., Гусаченко С. А., Клецкий Н. В., Мытник Г. И., Хомченко А. Я.</i>
Первичные источники тока $\text{Li/Cu}_4\text{V}_2\text{S}_{10}$. <i>Дудяк А. В., Заслонкин А. В., Ковалюк З. Д., Минтянский И. В., Савицкий П. И.</i>	2	Способы повышения эффективности многоканального фильтра доплеровского сигнала. <i>Василевский В. В., Головань В. Г., Дроздов М. А., Хижняк Т. А.</i>
Индуктивность, перестраиваемая электрическим полем. <i>Семёнов А. А., Усанов Д. А.</i>	5	Оптимизация процесса поиска неизвестного количества движущихся объектов. <i>Гришин И. Ю.</i>
Матричные кремниевые микрокатоды для автоэмиссионных дисплеев. <i>Дружинин А. А., Голота В. И., Козут И. Т., Ховерко Ю. М.</i>	6	Микропроцессорные устройства и системы
Электронные средства: исследования, разработки		Универсальная матрица структурно-логических преобразований n -мерного куба E^n единого кодирующего формата. <i>Иванов Ю. Д.</i>
Связь параметров спектральной плотности фликкер-шума с особенностями внутренней структуры системы. <i>Колодий З. А., Крук О. Г., Саноцкий Ю. В., Голынский В. Д., Колодий А. З., Делко П. И.</i>	1	Микропроцессор звездобразной структуры. <i>Синегуб Н. И.</i>
Расчет нормальных допусков с учетом отклонений коэффициентов внешних воздействий. <i>Шило Г. Н., Коваленко Д. А., Гапоненко Н. П.</i>	1	Умножитель/делитель с повышенным быстродействием. <i>Синегуб Н. И.</i>
Свойства коммутационных ячеек, используемых в системах автоматизированного контроля. <i>Медведик А. Д.</i>	2	Вопросы приборостроения
Физические основы проектирования зеркал оптических резонаторов полихромных лазеров. <i>Бондарчук Я. М., Петровская Г. А., Татарин В. Я.</i>	2	Аппаратура для мониторинга элементного состава полиметаллических руд РЛП-21. <i>Ефименко С. А.</i>
Непапаемые контактные соединения в электронных печатных узлах. <i>Ефименко А. А., Собченко Д. Л.</i>	3	Энергетическая электроника
Моделирование электрических характеристик и расчет конструктивных параметров кремниевого стабилизатора с напряжением стабилизации 6,5 В. <i>Дудар Н. Л., Сякерский В. С., Корытко Н. Н.</i>	3	Кремний мультипористой текстуры для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. <i>Ерохов В. Ю., Дружинин А. О.</i>
К вопросу о минимизации числа межслойных переходов при трассировке печатных плат. <i>Лужин С. Ю., Петросян Г. С., Полубасов О. Б.</i>	3	Биомедицинская электроника
Светофильтры с тонкопленочным прозрачным нагревателем. <i>Хомич И. Н.</i>	4	Устройство сбора биометрической информации с использованием тензотранзисторных датчиков. <i>Жильцов В. В., Костенко В. Л.</i>
Гибридный автодинный сенсор магнитного резонанса. <i>Браиловский В. В., Верига А. Д., Политанский Л. Ф.</i>	5	Сенсорная электроника
Установка для измерения удельного коэффициента силы света материалов со световозвращающим эффектом. <i>Бутенко В. К., Добровольский Ю. Г., Шабашкевич Б. Г., Юрьев В. Г.</i>	5	Анизотропный приемник теплового излучения на основе антимонида кадмия. <i>Добровольский Ю. Г., Шабашкевич Б. Г.</i>
		Магнитокоммутируемая микросхема и датчик измерения скорости ветра на ее основе. <i>Касимов Ф. Д., Ибрагимов Р. А., Свихнушин Н. М.</i>
		Датчик угла поворота генераторного типа с элементом на поверхностных акустических волнах. <i>Лепих Я. И.</i>
		Первичные преобразователи для микродатчиков ускорения и давления на алмазных материалах. <i>Алтухов А. А., Митягин А. Ю., Могучев А. В., Митягина А. Б.</i>

Оптимизация конструкции мембранных датчиков. *Рубцевич И. И., Высоцкий В. Б., Ковальчук Н. С.*

5

Дифференциальный термометр с высокой разрешающей способностью. *Готра З. Ю., Голяка Р. Л., Павлов С. В., Куленко С. С., Манус О. В.*

6

Радиоволновые датчики дымовых газов ТЭС. *Иванова Е. П., Радченко В. Ф., Ханамиров А. Е., Хрюнов А. В.*

6

Функциональная микро- и наноэлектроника

Инфракрасные отрезающие фильтры на основе монокристаллов CdSb, ZnSb для оптофототронных устройств. *Ащеулов А. А., Грицюк Б. Н., Стребежев В. Н.*

1

Применение гибких носителей при сборке кремниевых детекторов. *Перевертайло В. Л., Жора В. Д., Грунянская В. П., Пугач В. М., Тучинский И. А., Шкиренко Э. А.*

1

Измерение температуры с использованием оптических датчиков на основе двулучепреломляющих кристаллов. *Габа В. М.*

1

СБИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора приборов элементного анализа материалов. *Сидоренко В. П., Вербицкий В. Г., Прокофьев Ю. В., Кизяк А. Ю., Николаенко Ю. Е.*

2

Анализ влияния способа соединения столбиковых выводов интегральных схем на их сопротивление. *Готра З. Ю., Дячок Д. Т.*

2

Квантовое ограничение закона Мура. *Джеймс Р. Пауэлл*

3

Арсенид-галлиевые p^+-n-p^+ -структуры с обедняемой базовой областью. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А.*

3

Жидкокристаллические мониторы для авиационной техники. *Коваленко Л. Ф., Жураковский И. Ю., Сташевский В. В., Севастьянов В. В.* Модель линии передачи для наноэлектроники. *Нелин Е. А.*

4

Объемные оптические покрытия из халькогенидных стекол для полупроводниковых источников ИК-излучения. *Кабацкий В. Н.*

4

Разработка схемы и топологии элементов матрицы управляемых автоэмиссионных кремниевых микрокатодов. *Дружинин А. А., Голота В. И., Козут И. Т., Ховерко Ю. Н.*

5

Вольт-фарадные измерения в тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs. *Горев Н. Б., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н.*

5

Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе тонких пленок ZnS. *Бобренко Ю. Н., Ярошенко Н. В., Шереметова Г. И., Семикина Т. В., Атадаев Б. С.*

5

Измерения ВАХ импульсных кремниевых ЛПД на участке лавинного пробоя. *Кудрик Я. Я.*

5

Многофункциональная гомопереходная арсенид-галлиевая $n-p-t$ -структура. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Абдулхаев О. А., Гиясова Ф. А., Назаров Ж. Т.*

6

Влияние термического окисления на анизотропию электропроводности и фотопроводимости наноструктурированного кремния. *Форш П. А., Форш Е. А., Мартышов М. Н., Тимошенко В. Ю., Кашкаров П. К.*

6

Повышение зонной избирательности электромагнитных кристаллов. *Назарько А. И., Тимофеева Ю. Ф., Нелин Е. А., Попсуй В. И.*

6

Обеспечение тепловых режимов

Система термоэлектрического кондиционирования воздуха на основе проницаемых термоэлементов. *Черкез Р. Г.*

2

Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме ΔT_{max} . *Зайков В. П., Киншова Л. А., Моисеев В. Ф., Казанжи Л. Д., Ключников Д. А.*

4

Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме Q_{0max} . *Зайков В. П., Киншова Л. А., Казанжи Л. Д., Храмова Л. Ф.*

5

Технологические процессы и оборудование

Технология и оборудование для обработки алмазных материалов современной электроники. *Митягин А. Ю., Алтухов А. А., Митягина А. Б.* Электроосаждение конформных электродов для получения туннельного перехода с вакуумным нанозазором. *Джангидзе Л. Б., Тавхелидзе А. Н., Благодзе Ю. М., Талиашвили З. И.*

1

2

Бесконтактный метод определения эффективности термоэлектрических материалов. *Ащеулов А. А.*

2

Формирование МОП-транзисторов с изоляцией активных элементов окисленным пористым кремнием. *Новосядлый С. П., Вивчарук В. М.*

3

Прибор и методы измерения параметров и степени однородности пленочных структур. *Макара В. А., Одарич В. А., Кепич Т. Ю., Преображенская Т. Д., Руденко О. В.*

3

Корреляция параметров арсенид-галлиевых эпитаксиальных слоев и технологии их выращивания. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Якубов Э. Н.* Исследование погрешности сопротивления тонкопленочного резистора. *Спирин В. Г.*

5

5

Формирование мезоструктур $4HSiC$ $p-i-n$ -диодов методом ионно-плазменного травления. *Болтовец Н. С., Борисенко А. Г., Иванов В. Н., Федорович А. О., Кривуца В. А., Полозов Б. П.*

5

Закономерности формирования пучка ионов низкой энергии при помощи односеточной ионно-

оптической системы. *Дудин С. В., Рафальский Д. В.*

Особенности плазмохимического травления торцов кремниевых пластин для фотоэлектрических преобразователей. *Федорович О. А., Кругленко М. П., Полозов Б. П.*

Материалы электроники

Высокоэффективные катодные элементы для газоразрядных источников света. *Севастьянов В. В., Шутковский В. В.*

Гетероструктуры, полученные методом отжига монокристаллов InSe в парах серы. *Ковалюк З. Д., Кушнир О. И., Сидор О. Н., Нетьяга В. В.*

Изменение свойств пленок кремнийорганических стекол после термической и плазмохимической обработки. *Иванчиков А. Э., Кисель А. М., Медведева А. Б., Плебнович В. И.*

Оценка параметров компонентов моноармированной стеклокерамики со стеклокристаллической матрицей. *Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.*

Прогнозирование параметров стеклокерамики со стеклокристаллической матрицей для разных соотношений компонентов и режимов спекания. *Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.*

Разработка сцинтилляторов на основе соединений A^{IV}B^{VI} для медицинского и технического радиационного приборостроения. *Старжинский Н. Г., Зеня И. М., Катрунов К. А., Рыжиков В. Д.*

Влияние облучения кремния низкоэнергетическими ионами аргона на образование в нем электрически активных дефектов. *Попов В. М., Шустов Ю. М., Клименко А. С., Поканевич А. П.*

Модификация барьерной структуры на основе pAlGaInAs-nGaAs последовательно соединен-

ными потенциальными барьерами. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Гиясова Ф. А., Зоирова Л. Х., Абдулхаев О. А., Джураев Д. Р.*

Наноструктурированная композитная пленка для сенсоров влажности. *Коваленко К. Л., Шаран Н. Н., Севастьянов В. В.*

Способ определения доли кристаллов в стеклокерамическом диэлектрике. *Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.*

Адсорбционно-кинетическая модель осаждения пленок поликристаллического кремния, легированных фосфором в процессе роста. *Наливайко О. Ю., Турцевич А. С.*

Математические модели формирования химической связи твердых растворов CdSb-ZnSb. *Ащеулов А. А., Гуцул И. В., Маник О. Н., Маник Т. О.*

Метрология. Стандартизация

Измеритель динамического диапазона радиочастотных усилителей. *Дрозд С. С., Мамедов К. Я., Ямпольский Ю. С.*

От аттестации к мотивации. *Рудковский В. Н., Пик В. Н.*

Метод считывания и обработки стационарных интерференционных картин. *Ильин В. Н., Дубешко А. В., Михаевич Д. А.*

Малогабаритные цифровые частотомеры сверхвысокочастотного диапазона. *Криваль И. И., Скрипнюк А. И., Проценко В. А., Марьенко А. В.*

Библиография

Указатель статей, опубликованных в журнале в 2008 г.



Чобану М. Многомерные многоскоростные системы обработки сигналов.— М.: Техносфера, 2009.— 480 с.

Рассматриваются многомерные многоскоростные системы, которые используются для обработки ММ цифровых сигналов. Монография является первым систематическим изложением теории и методов неразделимой обработки ММ-сигналов на русском языке, в ней приводится все необходимое для разработки ММ многоскоростных систем, начиная с фундаментальных результатов из теории цифровой обработки ММ-сигналов и заканчивая алгоритмами и программным/аппаратным обеспечением для ММ многоскоростных систем. Особенностью монографии является применение математических пакетов MATLAB, MAPLE, Singular и др., а также программ, написанных на языке С, на протяжении всего изложения. Приведены результаты реализации разработанных неразделимых операторов на основе процессоров общего назначения, сигнальных процессоров фирмы Texas Instruments и графических процессоров (GPU) фирмы nVidia.

